

## 第四章 發明單一性

劃線版

公聽討論

格式化: 字型: 16 點, 粗體

<b>1.單一性之概念</b> .....	<b>1</b>
<b>2.相同或對應之技術特徵</b> .....	<b>2</b>
2.1 相同技術特徵.....	2
2.2 對應技術特徵.....	2
<b>3.不同類型請求項之相同或對應技術特徵的判斷</b> .....	<b>3</b>
3.1 相同範疇之獨立項.....	3
3.2 不同範疇之獨立項.....	4
3.2.1 物與製造該物之方法.....	4
3.2.2 物與該物之用途.....	4
3.3 附屬項.....	5
3.4 以擇一形式記載之請求項.....	6
3.5 引用記載形式之請求項.....	6
<b>4.相同或對應之特別技術特徵</b> .....	<b>7</b>
<b>5.發明單一性之判斷</b> .....	<b>8</b>
5.1 明顯不具發明單一性.....	8
5.2 非明顯不具發明單一性.....	10
<b>6.審查對象的決定</b> .....	<b>11</b>
<b>7.審查注意事項</b> .....	<b>11</b>
<b>8.案例說明</b> .....	<b>12</b>
8.1 明顯不具發明單一性.....	12
8.2 非明顯不具發明單一性.....	18



## 第四章 發明單一性

申請發明專利應就每一發明提出申請，但二個以上發明屬於一個廣義發明概念，亦即具發明單一性者，得於一申請案中提出申請~~一~~，本章係就說明發明單一性之相關基準予以說明。

有關醫藥相關發明及生物相關發明之發明單一性的判斷，分別參照本篇第十三章 7.「發明單一性」及第十四章 7.「發明單一性」。

### 1.單一性之概念

每一申請專利之發明應各別提出申請，但考量申請人、公眾及專利專責機關在專利申請案的分類、檢索及審查上之便利，對於二個以上，原本應各別提出申請之發明，專利法規範二個以上之發明於技術上相互關聯而屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請，此即發明單一性之要求。

專利法所稱二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」，指二個以上之發明，於技術上相互關聯。「技術上相互關聯」，指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或對應的特別技術特徵~~一~~。其中「特別技術特徵（special technical feature）」係使指申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵，亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵。~~二個以上之發明屬於一個廣義發明概念者，即具發明單一性。~~

二個以上發明即使不具相同技術特徵，但具有技術上關聯性時，即屬仍可能具有對應的技術特徵，例如一請求項為具特定形狀陰螺紋的螺帽，另一請求項為具特定形狀陽螺紋的螺栓，該等陰陽形狀之螺紋係可相互螺合者，此時得認定兩二請求項中的陰、陽螺紋係具有對應的技術特徵。

~~特別技術特徵是為審查發明單一性所提出的概念，申請案中不同請求項或同一請求項二個以上發明是否具發明單一性，應先審究每一發明是否包含相同或對應的技術特徵，而後經檢索確認該相同或對應之技術特徵是否對先前技術有所貢獻，使每一發明相互關聯。~~

發明單一性之判斷，不受因請求項之記載形式而有差異撰寫方式之影響，不僅應對不同請求項所記載的不同二個以上發明進行判斷，亦須對於同單一請求項中以擇一形式記載的不同二個以上發明，亦須進行判斷。

發明單一性規定之立法意旨係有效利用審查資源，經審查核准後始發現不具發明單一性者，因由於所有請求項已經審查符合專利要件，尚不致直接損及社會公眾之利益，因此不構成舉發之理由。

專 33

專 33. II  
專 施 27. I

專 施 27. II

專 施 27. III

專 施 27. IV

## 2.相同或對應之技術特徵

### 2.1 相同技術特徵

二個以上發明間具有相同技術特徵之情形，例如：

#### 例 1.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種高分子化合物 A。
- 2.一種食品容器，包含高分子化合物 A。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為高分子化合物 A。

#### 例 2.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種照明方法，其特徵在於使一光源發出的光線，一部分被遮蔽。
- 2.一種照明系統，具有一光源及一光遮蔽元件，該光遮蔽元件用以

遮蔽該光源發出的部分光線。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為使光源發出的光線一部分被遮蔽之技術特徵。

### 2.2 對應技術特徵

二個以上發明間具有對應技術特徵之情形，例如：

#### 例 1.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種話筒，具有構造 A。
- 2.一種話機，具有可卡合構造 A 之承載部。

（由說明書記載內容可知話筒於收納時，其構造 A 可卡合於話機。）

〔說明〕

不同獨立項之對應技術特徵為請求項 1 之構造 A 與請求項 2 之可卡合構造 A 的承載部。

#### 例 2.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種發射器，其特徵在於視頻信號的時軸擴展器。
- 2.一種接收器，其特徵在於視頻信號的時軸壓縮器。

〔說明〕

請求項 1 具有「視頻信號的時軸擴展器」之技術特徵，請求項 2 具

有「視頻信號的時軸壓縮器」之技術特徵，二者係相互關聯而不能分開使用，屬於對應之技術特徵。

### 3.不同類型請求項之相同或對應技術特徵的判斷

複數二個以上發明間是否具有相同或對應的技術特徵，應於檢索前先行判斷。本節即依請求項之記載方式例示相同或對應技術特徵之具體判斷方式。

#### 23.1 相同範疇之獨立項

相同範疇之獨立項，指各獨立項之標的均為物之發明或均為方法之發明，其可能包含相同或對應之技術特徵。~~其相同或對應之技術特徵，通常包括以下情形：~~

##### 例 1.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種軸承，具構造 A。
- 2.一種變速箱，包含具構造 A 之軸承。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為具構造 A 之軸承。

##### 例 2.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種製造產物 A 之方法，包含下列步驟：(a)……；(b)……；(c)將原料 C 加溫至 200°C ~ 250°C。
- 2.一種製造產物 B 之方法，包含下列步驟：(a')……；(b')……；(c)將原料 C 加溫至 200°C ~ 250°C。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為將原料 C 加溫至 200°C ~ 250°C 之步驟。

- ~~(1)請求項 1 為高分子化合物 A，請求項 2 為由高分子化合物 A 組成之食品容器。不同請求項之相同技術特徵為高分子化合物 A。~~
- ~~(2)請求項 1 為具特定構造之軸承，請求項 2 為使用與請求項 1 所載相同構造軸承之變速箱。不同請求項之相同技術特徵為軸承。~~
- ~~(3)請求項 1 所載為產物 A 之製造方法，其中包含一個將原料 C 加溫至 200°C ~ 250°C 之步驟。請求項 2 所載為產物 B 之製造方法，其中包含一個將原料 C 加溫至 200°C ~ 250°C 之步驟。不同請求項之相同技術特徵為將原料 C 加溫至 200°C ~ 250°C 之步驟。~~
- ~~(4)請求項 1 為具有一凸起握持部之鋼珠筆，請求項 2 為上方具有一凹陷~~

~~承座部之紙鎮。由說明書記載內容可知鋼珠筆於收納時，其握持部可卡合於紙鎮之承座部。不同請求項之對應技術特徵為請求項 1 之凸起握持部與請求項 2 之凹陷承座部。~~

### 23.2 不同範疇之獨立項

不同範疇之獨立項指各獨立項之標的分別包含物及方法之請求項，~~各發明間具有其可能包含~~相同或對應之技術特徵。~~例示如下：~~

#### 23.2.1 物與製造該物之方法

一獨立項為物之發明，另一獨立項為製造該物之方法的發明時，該等請求項之相同技術特徵即為該物。~~通常包括下列情形例示如下：~~

##### 例 1.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種煞車盤，具有構造 A 之來令片。
- 2.一種製造具有構造 A 之來令片的方法，包含步驟……。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為具有構造 A 之來令片。

##### 例 2：

〔申請專利範圍〕

- 1.一種鈦合金 X。
- 2.一種製造鈦合金 X 之方法，包含步驟……。
- 3.一種眼鏡框架，由鈦合金 X 製成。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為鈦合金 X。

~~(1)請求項 1 為煞車盤，具特定構造 A 之來令片，請求項 2 為具特定構造 A 之來令片的製造方法，具有特定步驟。不同請求項之相同技術特徵為特定構造 A 之來令片。~~

~~(2)請求項 1 為一種鈦合金 X，請求項 2 為一種鈦合金 X 之製造方法，請求項 3 為一種眼鏡框架，由特定材質之鈦合金 X 製成。不同請求項之相同技術特徵為該鈦合金 X。~~

#### 23.2.2 物與該物之用途

一獨立項為物之發明，另一獨立項為該物之用途的方法發明。使用該物為限定該用途之技術特徵時，得認該等請求項之相同技術特徵即為該物。~~通常包括下列情形例示如下：~~

**例 1.**

〔申請專利範圍〕

- 1.一種物質 A。
- 2.一種使用物質 A 進行殺蟲之方法，包含步驟……。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為物質 A。

**例 2.**

〔申請專利範圍〕

- 1.一種烤漆噴頭，具有構造 A。
- 2.一種利用具有構造 A 之烤漆噴頭進行烤漆的方法，包含步驟……。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為具有構造 A 之烤漆噴頭。

~~(1)請求項 1 為物質 A。請求項 2 為使用物質 A 殺蟲的方法。不同請求項之相同技術特徵為物質 A。~~

~~(2)請求項 1 為具特定構造之烤漆噴頭。請求項 2 為利用特定構造之烤漆噴頭烤漆之方法。不同請求項之相同技術特徵為烤漆噴頭。~~

**2.3 以擇一形式記載之請求項**

~~以擇一形式記載之請求項，於該單一請求項之複數發明，除共通內容外，另包含不同選項之技術特徵，該共通內容即為複數發明之相同技術特徵。例如請求項 1 為一種電路板，具特定層狀構造，其中導線之材質為金、銀或銅。不同發明之相同技術特徵為特定層狀構造。~~

**23.43 附屬項**

依附於同一獨立項之各附屬項包含該獨立項所有的技術特徵，因此獨立項之內容即為獨立項與其附屬項之相同技術特徵。

**例 1.**

〔申請專利範圍〕

- 1.一種渦輪機葉片，其特徵在於該葉片具有形狀 X。
- 2.如請求項 1 之渦輪機葉片，其中該葉片之材質為合金 A。

〔說明〕

獨立項與其附屬項之相同技術特徵為具有形狀 X 之渦輪機葉片。

~~例如請求項 1 是一種渦輪機之葉片，其特徵在於該葉片之特殊形狀，請求項 2 是依附請求項 1 之渦輪機葉片，其中該葉片的材質為合金 A。~~

~~請求項 1 記載之渦輪機葉片的特殊形狀即為請求項 1、2 之相同技術特徵。~~

依附於不同獨立項之各附屬項，若各獨立項間具有相同或對應之技術特徵，則該等獨立項與附屬項具有相同或對應之技術特徵。各獨立項間之相同或對應技術特徵的判斷，參見照本章「2.1 相同範疇之獨立項」及「2.2 不同範疇之獨立項」。

### 3.34 以擇一形式記載之請求項

以擇一形式記載之請求項，於該單一請求項之複數發明，除共通內容外，另包含不同選項之技術特徵，該共通內容即為複數發明之相同技術特徵。~~例如請求項 1 為一種電路板，具特定層狀構造，其中導線之材質為金、銀或銅。不同發明之相同技術特徵為特定層狀構造。~~

#### 例 1.

〔申請專利範圍〕

一種電路板，具特定層狀構造，其中導線之材質為金、銀或銅。

〔說明〕

請求項中不同發明之相同技術特徵為特定層狀構造。

### 3.5 引用記載形式之請求項

如申請專利範圍中一項或多項請求項以引用記載形式撰寫，被引用之請求項內容，即屬各請求項間之相同或對應之技術特徵。~~通常包括下列情形：~~

#### 例 1.

〔申請專利範圍〕

1. 一種軸承，具有構造 A。

2. 一種支架，包含如請求項 1 之軸承。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為請求項 1 之軸承。

#### 例 2.

〔申請專利範圍〕

1. 一種化合物 A。

2. 一種製造如請求項 1 之化合物 A 的方法，包含步驟……。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為請求項 1 之化合物 A。



**例 3.**

〔申請專利範圍〕

- 1.一種組成物 A，包含……。
- 2.一種殺蟲方法，其係使用請求項 1 之組成物 A。

〔說明〕

不同獨立項之相同技術特徵為請求項 1 之組成物 A。

**例 4.**

〔申請專利範圍〕

- 1.一種平頭螺栓，具有惠氏粗螺紋之公螺牙。
- 2.一種方形螺帽，係配合請求項 1 之平頭螺栓而具有該惠氏粗螺紋之母螺牙。

〔說明〕

不同獨立項之對應技術特徵為請求項 1 之公螺牙及請求項 2 之配合請求項 1 之母螺牙。

~~(1)請求項 1 為一種具特定構造之軸承，請求項 2 為具有請求項 1 之軸承的支架。相同技術特徵為請求項 1 之軸承。~~

~~(2)請求項 1 為物質 A，請求項 2 為製造請求項 1 之物質 A 的方法。相同技術特徵為請求項 1 之物質 A。~~

~~(3)請求項 1 為物質 A，請求項 2 為使用請求項 1 之物質 A 殺蟲的方法。相同技術特徵為請求項 1 之物質 A。~~

**34.相同或對應之特別技術特徵**

「特別技術特徵」係指申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵，亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵，原則上，應經檢索先前技術比對後予以確認。若二個以上之發明間具有相同或對應之特別技術特徵，則具有發明單一性。

**例 1.**

〔申請專利範圍〕

- 1.一種桌子，具有 A 構造之桌腳。
- 2.一種桌子，具有 A 構造之桌腳及 B 構造之桌面。

〔假設〕

就先前技術而言，具有 A 構造之桌腳的桌子符合專利要件。

〔說明〕

獨立項 1 中具有 A 構造之桌腳為特別技術特徵，獨立項 2 亦具有該特別技術特徵，故獨立項 1、2 具有發明單一性。

**例 2.**

〔申請專利範圍〕

- 1.一種桌子，具有 A 構造之桌腳。
- 2.如請求項 1 之桌子，……。
- 3.一種桌子，具有 A 構造之桌腳及 B 構造之桌面。
4. 如請求項 3 之桌子，……。

〔假設〕

就先前技術而言，具有 A 構造之桌腳的桌子符合專利要件。

〔說明〕

具有 A 構造之桌腳為獨立項 1、3 的特別技術特徵，附屬項 2、4 亦具有該特別技術特徵，故請求項 1 至 4 具有發明單一性。

**35.發明單一性之判斷步驟**

若申請專利範圍包含二個以上獨立項，針對各獨立項所載之發明，於檢索前先判斷是否有 5.1「明顯不具發明單一性」的情形；若非屬該情形，則屬於 5.2「非明顯不具發明單一性」的情形。

換言之，發明單一性之判斷，包括以下步驟：

(1)判斷各獨立項所載之發明間是否明顯不具發明單一性。

若各發明間無相同或對應之技術特徵，或依說明書、申請專利範圍及圖式所記載先前技術即得認定各獨立項相同或對應之技術特徵係屬先前技術或申請時之通常知識，則二發明之間明顯不具有相同或對應之特別技術特徵，不具發明單一性。

(2)檢索先前技術。

若各獨立項所載之發明並非明顯不具發明單一性，則應檢索先前技術，原則上，由請求項 1 記載之發明開始檢索，判斷該發明是否具有特別技術特徵，若不具特別技術特徵，則各獨立項之發明間即無相同或對應之特別技術特徵，不具發明單一性。

(3)若請求項 1 之發明具有特別技術特徵，則進一步判斷其他獨立項之發明是否均有至少一個技術特徵與請求項 1 之特別技術特徵相同或對應，若是，則該其他獨立項之發明與請求項 1 之發明間具有發明單一性；若否，亦即至少一獨立項之發明欠缺任何技術特徵與請求項 1 之特別技術特徵相同或對應，則不具發明單一性。

~~若申請專利範圍包含二個以上發明，審查發明單一性時，應先預選特別技術特徵，其次檢索先前技術，並就所檢索到的引證文件與所有發明進行比對確定特別技術特徵，以判斷是否具發明單一性。~~

**35.1 預選特別技術特徵明顯不具發明單一性**

~~審查申請專利範圍中二個以上之發明是否具發明單一性時，應先參~~

照說明書、申請專利範圍及圖式所記載之先前技術，於各發明之技術特徵中選擇有別於先前技術者作為特別技術特徵。

若各發明間無相同或對應之技術特徵，或依說明書、申請專利範圍及圖式所記載先前技術即得認定各獨立項相同或對應之技術特徵係屬習知技術，則不具發明單一性。例如下列情形：

(1)二獨立項所載之發明分別為除草劑及割草機，除草劑之技術特徵為組成物之成分，而割草機之技術特徵為不同元件之組成及其連結關係，兩者之間無相同或對應之技術特徵，不具發明單一性。

(2)參照說明書、申請專利範圍及圖式所記載之先前技術，若請求項 1、3 與先前技術有別之技術特徵為手機天線，請求項 2、3 與先前技術有別之技術特徵為手機螢幕，且手機天線與手機螢幕不相同亦不對應，則請求項 1、2、3 間無相同或對應的特別技術特徵，不具發明單一性。

申請專利範圍明顯不具發明單一性，通常包括下列情形：

(1)各獨立項所載之發明間無相同或對應之技術特徵。

例如，二獨立項所載之發明分別為除草劑及割草機，除草劑之技術特徵為組成物之成分，而割草機之技術特徵為不同元件之組成及其連結關係，二發明之間無相同或對應之技術特徵，因此不具發明單一性。又例如，二獨立項所載之發明分別為手機天線及手機螢幕，手機天線之技術特徵為天線元件之組成及其連結關係，而手機螢幕之技術特徵為觸控面板元件之組成及其連結關係，二發明之間無相同或對應之技術特徵，因此不具發明單一性。

(2)依說明書、申請專利範圍及圖式所記載先前技術即得認定各獨立項相同或對應之技術特徵係屬先前技術或申請時之通常知識。

預選特別技術特徵時，應儘可能使所有請求項均包含相同或對應之特別技術特徵，通常應優先於物之請求項中預選特別技術特徵。例如當申請專利範圍包含化合物、組成物、製造化合物之方法及該化合物之用途等不同請求項時，應先於技術內容涵蓋最廣的請求項(化合物請求項)中預選特別技術特徵，若無物之請求項，始於方法請求項中預選。

預選特別技術特徵為後續進行檢索之基礎，若部分請求項不具發明定義或記載要件等不准專利事由，因此無法對該等請求項進行檢索時，不以該等請求項為預選特別技術特徵之對象，而改以其他請求項為預選對象。

於預選特別技術特徵階段即得認定不具發明單一性時，得先不進行檢索，並於審查意見通知中指出不具發明單一性之不准專利事由，惟考量審查效率，亦得針對部分請求項先行檢索。如有其他未經檢索即得認定之不准專利事由，應一併通知，待申請人申復或修正後再續行審查。

### 3.5.2 檢索先前技術非明顯不具發明單一性

於檢索先前技術時，原則上，應由請求項 1 記載之發明開始進行，並與相關先前技術進行比對，以判斷請求項 1 記載之發明是否具有特別技術特徵。

若請求項 1 之發明具有特別技術特徵，則進一步判斷其他獨立項之發明是否均有至少一個技術特徵與請求項 1 之特別技術特徵相同或對應，若是，則該其他獨立項之發明與請求項 1 之發明間具有發明單一性。若否，亦即至少一獨立項之發明欠缺任何技術特徵與請求項 1 之特別技術特徵相同或對應，則不具發明單一性。

若請求項 1 之發明不具特別技術特徵，則各請求項之發明間無相同或對應之特別技術特徵，不具發明單一性。

檢索先前技術時，原則上應由請求項 1 記載之發明開始進行，惟若有下列情形之一，則由其他獨立項開始進行，包括：

(1)請求項 1 有因不符合記載要件而無法確認申請專利之發明的內容、不符發明定義、屬法定不予發明專利之標的、不具產業利用性之情形。

(2)請求項 1 顯非最能代表發明之獨立項，例如，申請專利範圍包含化合物、組成物、製造該化合物之方法及該化合物之用途等不同請求項，應先由化合物獨立項進行檢索，若無物之請求項，則由方法獨立項進行檢索。

應就技術內容涵蓋最廣，亦即作為限制條件之技術特徵最少的獨立項所載之發明開始進行檢索，並與相關先前技術進行比對，以確定該預選之特別技術特徵是否使請求項所記載之發具新穎性、進步性。

於檢索先前技術後，可能認定一個或多個請求項所記載之發明不具新穎性、進步性；或部分請求項所記載發明雖具新穎性、進步性，但各請求項間相同或對應之技術特徵屬先前技術之內容，在前述情形中，各請求項所載之發明間即無相同或對應之特別技術特徵，非屬同一廣義發明概念，不具發明單一性。

當檢索先前技術後認定申請專利範圍不具發明單一性時，得先停止檢索，並進行次一步驟之逐項判斷。

### 3.3 逐項判斷

依 3.2 節之步驟進行檢索後，應依檢索到的引證文件對各請求項之所有發明進行新穎性、進步性之判斷，同時判斷是否不具發明單一性，其結果通常包括下列情形：

- (1)依先前預選之特別技術特徵得認定所有請求項均具新穎性及進步性，則申請專利範圍具發明單一性。
- (2)認定所有請求項均不具新穎性或進步性，雖申請專利範圍不具發明單

~~一性，惟已就所有請求項進行前案比對，因此審查意見通知得僅指出所有請求項不具新穎性或進步性之不准專利事由。至於申請專利範圍不具發明單一性之不准專利事由，因屬必然結果，得不另外指出。~~

~~(3)認定部分請求項不具新穎性或進步性，但依檢索到的引證文件，仍無法認定其他請求項不具新穎性或進步性。此時申請專利範圍不具發明單一性，於審查意見通知中應指出部分請求項不具新穎性或進步性及申請專利範圍不具發明單一性之不准專利事由，並應指出因不具發明單一性而未檢索之請求項。~~

~~(4)認定部分請求項具有新穎性、進步性，但其他請求項因不具發明單一性（例如請求項之相同或對應技術特徵屬習知技術）而不進行檢索。此時應於審查意見通知敘明部分請求項經檢索後未發現足以認定其不具新穎性、進步性之引證文件，並指出申請專利範圍不具發明單一性之不准專利事由及因不具發明單一性而不進行檢索之請求項。~~

#### 56. 審查對象的決定

由於獨立項與其附屬項之間通常具有發明單一性，且獨立項與其附屬項一併審查較符合審查效率，應至少將一獨立項與其附屬項所構成之請求項群組納入審查對象，原則上，該獨立項即為請求項 1。

審查意見通知應將審查對象中所有不准專利事由或經審查暫無不准專利事由，通知申請人，並檢附檢索報告。若依檢索到的引證文件可以認定其他群組之請求項不具新穎性或進步性者，得一併通知。

應注意者，若審查對象已包括所有請求項，認定其均不具新穎性或進步性，此時，申請專利範圍不具發明單一性之不准專利事由，因屬必然結果，得不另外指出。惟若申請專利範圍尚有部分請求項因不具單一性而未進行檢索，審查意見通知應指出不具發明單一性之不准專利事由及因不具單一性而未進行檢索之請求項。

#### 47. 審查注意事項

(1)如預選之特別技術特徵對應所有申請專利之發明，經檢索後僅發現使請求項不具擬制喪失新穎性或違反先申請原則之先申請案，因未發現足以認定請求項不具新穎性、進步性之引證文件，故仍具發明單一性。

(2)發明單一性之判斷不受請求項記載形式之影響，以擇一形式記載之請求項的不同發明經檢索後，如請求項中以擇一形式記載的一個或多個發明不具新穎性或進步性，該請求項記載之複數發明間即無相同或對應之特別技術特徵，若不具發明單一性，即使在修正時將該請求項所記載之複數發明修正為複數請求項，仍不具發明單一性。

(3)獨立項與附屬項間之相同技術特徵為獨立項之內容，經檢索後，若獨

立項被認定欠缺新穎性或進步性，將導致獨立項與其附屬項間即無相同或對應之特別技術特徵，不具發明單一性，於修正時如僅刪除獨立項，並將其他附屬項改寫為不同獨立項，修正後各獨立項間相同或對應技術特徵如仍僅為該遭刪除之獨立項內容，仍不具發明單一性。

- (4)經檢索後，以部分請求項不具新穎性、進步性，導致申請專利範圍所記載各發明不具發明單一性而發給審查意見通知，申請人於申復或修正後，若以原引證文件仍得認定其不具發明單一性時，即屬未能克服原不准專利事由，得作成核駁審定。
- (5)對於不具發明單一性之申請案，申請人雖得以分割方式就不同發明申請專利，但不宜主動於審查意見中要求申請人申請分割。

## 5.8. 案例說明

### 5.8.1 相同範疇獨立項之明顯不具發明單一性

#### 例 1.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種瓦斯自動遮斷裝置，其特徵在於具有連接至氣閥(3)之雙金屬片(4)以及將燃燒器之溫度傳導至該雙金屬片(4)之受熱板，當該雙金屬片(4)之溫度下降時，該雙金屬片(4)的變形會造成該氣閥(3)的關閉。
- 2.一種瓦斯自動遮斷裝置，其特徵在於具有永久磁石(19、21)、在該永久磁石(19、21)之磁力線通路上之至少二個熱鐵氧磁體(20、22、23)、藉由該熱鐵氧磁體(20、22、23)之磁力吸附力以保持開閉位置之氣閥(25)以及將燃燒器之溫度傳導至該熱鐵氧磁體(20、22、23)之受熱板，……當溫度異常時，該熱鐵氧磁體(20、22、23)之磁性即消失。

〔假設〕

說明書記載瓦斯自動遮斷裝置之先前技術為係以電路與馬達控制氣閥，本案以請求項所載之兩種機械構造取代習知之電子式構造。

〔說明〕

請求項 1、2 均為「瓦斯自動遮斷裝置」，請求項 1 是係利用雙金屬片之變形控制瓦斯器，利用雙金屬片控制氣閥，請求項 2 是係利用熱鐵氧磁體之不同消磁溫度使經過該磁體之磁力線量不同，藉以改變氣閥位置。兩者之間除習知之氣閥外，無相同或對應之技術特徵，故不具發明單一性。

#### 例 2.

〔申請專利範圍〕



- 1.一種電源之整流器電路，……。
- 2.一種多孔矽藍光發光二極體之製造方法……。

〔說明〕

請求項 2 之「藍光發光二極體之製造方法」與請求項 1 之「整流器電路」無關，請求項 1、2 無相同或對應之特別技術特徵，故不具發明單一性。

### 例 3.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種在液相中的芳香族化合物之硝化反應之方法，……。
- 2.一種除去液相中芳香族化合物硝化反應之反應熱的裝置，……。

〔說明〕

請求項 2 之「除去液相中芳香族化合物硝化反應之反應熱的裝置」並非實施請求項 1 之「硝化反應方法」所使用者，請求項 1、2 無相同或對應之特別技術特徵，故不具發明單一性。

### 例 1.

~~〔申請專利範圍〕~~

- ~~1.一種產物 X，其特徵為 A。~~
- ~~2.一種產物 Y，其特徵為 B。~~
- ~~3.一種產物 Z，其特徵為 A 及 B。~~

~~〔假設〕~~

~~就先前技術而言，具有特徵 A 或 B 的該產物符合專利要件，而 A 與 B 不相關。~~

~~〔說明〕~~

~~請求項 1 中的特徵 A 為特別技術特徵，請求項 3 亦具有該特徵 A，兩項具有相同之特別技術特徵，同理，請求項 2 與請求項 3 具有相同之特別技術特徵 B。惟請求項 1、2 不具相同或對應之特別技術特徵，故請求項 1、2、3 項間仍無相同或對應的特別技術特徵，不具發明單一性。但申請人如申請分割，仍得就不同發明內容取得專利權。~~

### 例 2.

~~〔申請專利範圍〕~~

- ~~1.一種插頭，具有 A 之凸出結構。~~
- ~~2.一種插座，具有與 A 結構配合之凹陷形狀。~~

~~〔假設〕~~

~~就先前技術而言，具有特徵 A 的插頭符合專利要件。~~

~~〔說明〕~~

~~請求項 1、2 的插頭與插座具有相互配合之形狀，屬對應特別技術特~~

~~徵，具發明單一性。~~



**例3.**

〔申請專利範圍〕

- 1.一種發射器，其特徵在於視頻信號的時軸擴展器。
- 2.一種接收器，其特徵在於視頻信號的時軸壓縮器。
- 3.一種傳送視頻信號的設備，包含請求項1的發射器及請求項2的接收器。

〔假設〕

就先前技術而言，具有時軸擴展器之發射器及具有時軸壓縮器之接收器符合專利要件。

〔說明〕

請求項1的特別技術特徵為視頻信號的時軸擴展器，請求項2的特別技術特徵為視頻信號的時軸壓縮器，兩者於進行信號之時軸擴展與時軸壓縮時，係使用相同的演算法且須搭配使用，屬於對應的特別技術特徵，請求項3包含請求項1、2兩者對應的特別技術特徵，故請求項1~3具發明單一性。

**例4.**

〔申請專利範圍〕

- 1.一種用於紡織機的控制電路，具有特徵A。
- 2.一種用於紡織機的控制電路，具有特徵B。
- 3.一種○○設備，包括一台具有特徵A控制電路的紡織機。
- 4.一種○○設備，包括一台具有特徵B控制電路的紡織機。

〔假設〕

就先前技術而言，具有特徵A之紡織機控制電路及具有特徵B之紡織機控制電路符合專利要件，而特徵A與B完全不相關。

〔說明〕

特徵A為請求項1、3的特別技術特徵，特徵B為請求項2、4的特別技術特徵。由於A與B完全不相關，非屬相同或對應之技術特徵，雖請求項1、3間具單一性，請求項2、4間亦具單一性，但請求項1~2~3、4間無相同或對應的特別技術特徵，故不具發明單一性。

**例5.**

〔申請專利範圍〕

- 1.一種燈絲A，……。
- 2.一種以燈絲A製成之燈泡B。
- 3.一種探照燈D，裝有以燈絲A製成之燈泡B及旋轉裝置C。

〔假設〕

就先前技術而言，燈絲A符合專利要件。

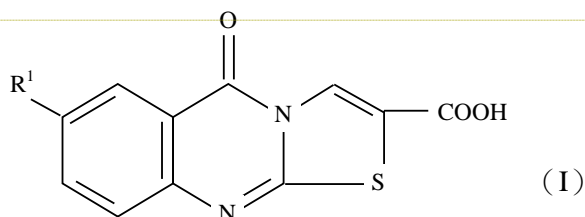
〔說明〕

請求項 1、2、3 均具有相同的特別技術特徵燈絲 A，故具發明單一性。

**例 6.**

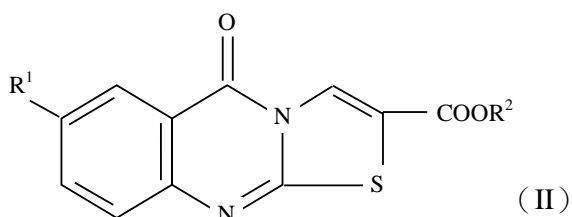
〔申請專利範圍〕

1. 一種式(I)表示之噻唑基〔2,3, b〕噻唑啉衍生物



式內，R<sup>1</sup> 表示甲硫基或甲磺基。

2. 一種式(II)表示之噻唑基〔2,3, b〕噻唑啉衍生物



式內，R<sup>1</sup> 為甲硫基或甲磺基，R<sup>2</sup> 為烷基。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 2 之化合物（中間體）符合專利要件。

〔說明〕

請求項 2 之化合物為請求項 1 之化合物（最終產物）的原料，為請求項 1、2 相同的特別技術特徵，故具發明單一性。

**例 7.**

〔申請專利範圍〕

1. 一種木材紙漿淤泥濃縮機用過濾圓筒，.....。

2. 一種木材紙漿淤泥濃縮機，包含請求項 1 中之過濾圓筒.....。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1「過濾圓筒」之構造符合專利要件。

〔說明〕

請求項 1 之「過濾圓筒」為請求項 2「濃縮機」的構成元件之一，請求項 1、2 相同的特別技術特徵為「過濾圓筒」，故具發明單一性。

格式化: 字型: (中文) 標楷體, 14 點

## 例8:

〔申請專利範圍〕

- 1.一種半導體隨機存取記憶體裝置，其特徵在於將具有由第一 MIS 元件，採用此第一 MIS 元件之漏極及源極領域之任一領域作為閘，且於前述第一 MIS 元件之上部疊積形成的第二 MIS 元件，……配置成矩陣狀的記憶體陣列，將資訊線 (D1) 配線於記憶體存格間使記憶體陣列直交於感線 (S1) 及字線 (W1) 而成者。
- 2.一種 MIS 型半導體裝置，其特徵在於由被形成於半導體基板之一主面上的第一 MIS 元件，與採用此第一 MIS 元件之漏極及源極領域之任一領域作閘，且於前述第一 MIS 元件之上部，疊積形成的第二 MIS 元件而成者。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 2「MIS 型半導體裝置」符合專利要件。

〔說明〕

請求項 2「MIS 型半導體裝置」為請求項 1「半導體隨機存取記憶體裝置」的構成元件之一，請求項 1 包含請求項 2 之內容，請求項 1、2 相同的特別技術特徵為「MIS 型半導體裝置」，故具發明單一性。

## 例9:

〔申請專利範圍〕

- 1.一種瓦斯自動遮斷裝置，其特徵在於具有連接至氣閥(3)之雙金屬片(4)以及將燃燒器之溫度傳導至該雙金屬片(4)之受熱板，當該雙金屬片(4)之溫度下降時，該雙金屬片(4)的變形會造成該氣閥(3)的關閉。
- 2.一種瓦斯自動遮斷裝置，其特徵在於具有永久磁石(19、21)在該永久磁石(19、21)之磁力線通路上之至少二個熱鐵氧磁體(20、22、23)，藉由該熱鐵氧磁體(20、22、23)之磁力吸附力以保持開閉位置之氣閥(25)以及將燃燒器之溫度傳導至該熱鐵氧磁體(20、22、23)之受熱板，……當溫度異常時，該熱鐵氧磁體(20、22、23)之磁性即消失。

〔假設〕

說明書記載瓦斯自動遮斷裝置之先前技術為以電路與馬達控制氣閥，本案以請求項所載之兩種機械構造取代習知之電子式構造。

〔說明〕

請求項 1、2 均為「瓦斯自動遮斷裝置」，請求項 1 是利用雙金屬片之變形控制瓦斯器，利用雙金屬片控制氣閥，請求項 2 是利用熱鐵氧磁體之不同消磁溫度使經過該磁體之磁力線量不同，藉以改變氣閥位置。兩者之間除習知之氣閥外，無相同或對應之技術特徵，故不具發明單一性。

性。

#### 例 10.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種旅行箱，包含箱體，……；蓋體，……；鉸接部，……；扣接部，……；其特徵在於，箱體內部設有加勁肋條。
- 2.如請求項 1 記載之旅行箱，其中該箱體係呈四角為圓角的長方體。
- 3.如請求項 2 記載之旅行箱，其中該加肋條設於該箱體內側底面對角線與該箱體側邊。
- 4.如請求項 2 記載之旅行箱，於該箱體一側設有握把，該握把又包括以下構造：……。
- 5.如請求項 2 記載之旅行箱，於該箱體一側設有滑輪，該滑輪又包括以下構造：……。
- 6.如請求項 2 記載之旅行箱，其中該扣接部進一步包含一四位數之密碼鎖。

〔假設〕

經檢索後，發現於引證文件中已揭露一具有特定形狀之旅行箱，具有特定形狀之強化用肋條及號碼鎖等構造，對應請求項 1、2、3、6 之內容。

〔說明〕

經初步判斷，請求項 1~6 得以請求項 1 之技術內容作為預選之特別技術特徵，惟經檢索後認定請求項 1 不具新穎性，故各請求項所載之發明間無相同或對應之特別技術特徵，非屬同一廣義發明概念，故不具發明單一性。

請求項 2~6 直接或間接依附於請求項 1，因各請求項間已無相同或對應之特別技術特徵，此時得暫不進行進一步的檢索，於審查意見通知中應指出依現有引證文件內容認定請求項 1、2、3、6 不具新穎性、進步性及請求項 1~6 不具發明單一性之不准專利事由，並敘明請求項 4、5 因不具發明單一性而未檢索，待申請人申復後再續行審查。

#### 578.2 不同範疇獨立項之非明顯不具發明單一性

##### 【具有發明單一性】

#### 例 1.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種燈絲 A，……。
- 2.一種以燈絲 A 製成之燈泡 B。

3.一種探照燈 D，裝有以燈絲 A 製成之燈泡 B 及旋轉裝置 C。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「燈絲 A」符合專利要件。

〔說明〕

請求項 1、2、3 均具有相同的之特別技術特徵「燈絲 A」，故具有發明單一性。

### 例 2.

〔申請專利範圍〕

1.一種木材紙漿淤泥濃縮機用過濾圓筒，……。

2.一種木材紙漿淤泥濃縮機，包含請求項 1 中之過濾圓筒……。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「過濾圓筒」~~之構造~~符合專利要件。

〔說明〕

請求項 1 之「過濾圓筒」為請求項 2「濃縮機」的構成元件之一，請求項 1、2 相同的之特別技術特徵為「過濾圓筒」，故具有發明單一性。

### 例 3.

〔申請專利範圍〕

1.一種半導體隨機存取記憶體裝置，其特徵在於將具有由第一金屬-絕緣層-半導體 (metal - insulator - semiconductor, MIS) 元件，採用此第一 MIS 元件之漏汲極及源極領域之任一領域作為閘、且於前述第一 MIS 元件之上部疊積形成的第二 MIS 元件，……配置成矩陣狀的記憶體陣列，將資訊線 (D1) 配線於記憶體存格間使記憶體陣列直交於感線 (S1) 及字線 (W1) 而成者。

2.一種 MIS 型半導體裝置，其特徵在於由被形成於半導體基板之一主面上的第一 MIS 元件、與採用此第一 MIS 元件之漏汲極及源極領域之任一領域作閘，且於前述第一 MIS 元件之上部~~→~~疊積形成的第二 MIS 元件而成者。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「半導體隨機存取記憶體裝置」~~2「MIS 型半導體裝置」~~符合專利要件。

〔說明〕

請求項 2 之「MIS 型半導體裝置」為請求項 1 之「半導體隨機存取記憶體裝置」的構成元件之一，請求項 1 包含請求項 2 之內容，請求項 1、2 具有「第一 MIS 元件之汲極及源極領域之任一領域作閘，且於前述第一 MIS 元件之上部疊積形成的第二 MIS 元件」之相同的特別技術特徵為「~~MIS 型半導體裝置~~」，故具有發明單一性。

**例 4.**

〔申請專利範圍〕

- 1.一種產物 X。
- 2.一種製造產物 X 的方法 A，包含步驟 J，步驟 K，步驟 L。
- 3.一種製造產物 X 的方法 B，包含步驟 M，步驟 N，步驟 O。
- 4.一種製造產物 X 的方法 C，包含步驟 P，步驟 Q，步驟 R。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「產物 X」符合專利要件。

〔說明〕

請求項 1 之「產物 X」為物之請求項 1 及方法請求項 2、3、4 之相同的特別技術特徵，故具有發明單一性。

**例 5.**

〔申請專利範圍〕

- 1.一種化合物 X。
- 2.一種製備化合物 X 的方法，包含下列步驟：……。
- 3.化合物 X 作為清潔劑的應用。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「化合物 X」符合專利要件。

〔說明〕

請求項 1 之「化合物 X」為即請求項 1、2、3 間之相同的特別技術特徵，故具有發明單一性。

**例 6.**

〔申請專利範圍〕

- 1.一種高強度、耐腐蝕的不鏽鋼帶，……其伸長率為 0.2 % 時之降服強度超過 50 kg/mm<sup>2</sup>。
- 2.一種製備如請求項 1 之不鏽鋼帶的方法，包含步驟……。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之伸長率為 0.2 % 時降服強度超過 50 kg/mm<sup>2</sup>的「不鏽鋼帶」符合專利要件。

〔說明〕

請求項 1 之不鏽鋼帶係以「伸長率為 0.2 % 時之降服強度超過 50 kg/mm<sup>2</sup>」為其特別技術特徵，請求項 2 之「製備不鏽鋼帶的方法」包含請求項 1 之「不鏽鋼帶」的全部技術特徵，因此亦包含該特別技術特徵請求項 2 之方法為說明書記載用以生產具該降服強度之不鏽鋼帶所採用者，請求項 2 雖未記載請求項 1 之該特別技術特徵，但說明書中已明確

揭露此事項，該等步驟為對應於請求項 1 內容之特別技術特徵，故具有發明單一性。

### 例 7.

〔申請專利範圍〕

1. 一種光纖電纜，包含一絞繞結構……。
2. 一種光纖電纜之製法，包含一搓撚步驟……。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「光纖電纜」包含之絞繞結構符合專利要件。請求項 2 之製法包含之搓撚步驟係於製造光纖電纜時形成該絞繞結構者。

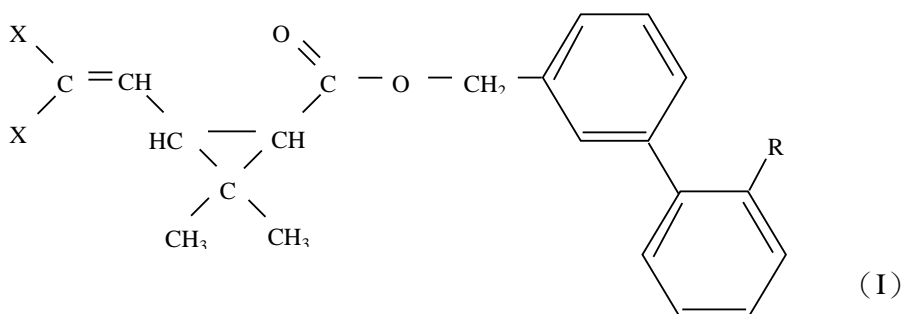
〔說明〕

請求項 2 之「搓撚步驟」技術特徵係與請求項 1 之「絞繞結構」技術特徵對應，故具有發明單一性。

### 例 8.

〔申請專利範圍〕

1. 一種環丙烷羧酸酯衍生物，係以一般式(I)表示者：



式內，X 為氯或溴，R 表示鹵素、低級烷基、三氟甲基或低級烷氧基。

2. 一種殺蟲劑組成物，其係含有至少一種請求項 1 所述的化合物為有效成分。
3. 一種殺蟲方法，其係將有效量之至少一種請求項 1 所述化合物施用於欲驅除昆蟲之場所。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「環丙烷羧酸酯衍生物」符合專利要件。

〔說明〕

請求項 2 之「殺蟲劑組成物」包含請求項 1 之「環丙烷羧酸酯衍生物」，請求項 3 之「殺蟲方法」係使用請求項 1 之「環丙烷羧酸酯衍生物」。

之方法，請求項 1 之「環丙烷羧酸酯衍生物」化合物為請求項 1、2、3 之相同的特別技術特徵，故具有發明單一性。

### 例 9.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種具有細胞碎裂電解裝置之微流裝置，包含有一陽極室、一陰極室以及一阻隔體……。
- 2.一種使用申請專利範圍請求項 1 之微流裝置進行碎裂細胞之方法，該方法包含：~~有~~自該陽極室之該入口導入該陽極室溶液…；自該陰極室之該入口導入該陰極室溶液……。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「碎裂微流裝置」符合專利要件。

〔說明〕

請求項 2 之碎裂細胞方法之步驟中，係使用請求項 1 的碎裂微流裝置，相同之技術特徵為請求項 1 之微流裝置為請求項 1、2 之相同的特別技術特徵，故請求項 1、2 具有發明單一性。

### 例 10.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種插頭，具有 A 之凸出結構。
- 2.一種插座，具有與 A 結構配合之凹陷形狀。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「插頭」符合專利要件。

〔說明〕

請求項 1、2 之「插頭」與「插座」具有相互配合的形狀，屬對應之特別技術特徵，故具有發明單一性。

### 【不具發明單一性】

### 例 11.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種產物 X。
- 2.一種製造產物 X 的方法 A，包含步驟 J，步驟 K，步驟 L。
- 3.一種製造產物 X 的方法 B，包含步驟 M，步驟 N，步驟 O。
- 4.一種製造產物 X 的方法 C，包含步驟 P，步驟 Q，步驟 R。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「產物 X」不符合專利要件。

〔說明〕



請求項 1 之「產物 X」不符合專利要件時，請求項 1、2、3、4 間即無相同或對應之特別技術特徵，故不具發明單一性。

### 例 12.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種化合物 X。
- 2.一種製備化合物 X 的方法，包含下列步驟：……。
- 3.化合物 X 作為清潔劑的應用。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「化合物 X」不符合專利要件。

〔說明〕

當請求項 1 之「化合物 X」不符合專利要件，應於審查意見通知指出化合物 X 不符合專利要件及請求項 1~1、2、3 無相同或對應之特別技術特徵，故不具發明單一性。

如經修正申請專利範圍刪除請求項 1 後，請求項 2、3 間之相同技術特徵若仍為「化合物 X」時，由於其非屬特別技術特徵，在無其他相同或對應之技術特徵的情況下，請求項 2、3 仍不具發明單一性。

### 例 13.

〔申請專利範圍〕

- 1.一種旅行箱，包含箱體，……；蓋體，……；鉸接部，……；扣接部，……；其特徵在於，箱體內部設有加勁肋條。
- 2.如請求項 1 記載之旅行箱，其中該箱體係呈四角為圓角的長方體。
- 3.如請求項 2 記載之旅行箱，其中該加肋條設於該箱體內側底面對角線與該箱體側邊。
- 4.如請求項 2 記載之旅行箱，於其中該箱體一側設有握把，該握把又包括以下構造：……。
- 5.如請求項 2 記載之旅行箱，於其中該箱體一側設有滑輪，該滑輪又包括以下構造：……。
- 6.如請求項 2 記載之旅行箱，其中該扣接部進一步包含一四位數之密碼鎖。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之「旅行箱」不符合專利要件經檢索後，發現於引證文件中已揭露一具有特定形狀之旅行箱，具有特定形狀之強化用肋條及號碼鎖等構造，對應請求項 1、2、3、6 之內容。

〔說明〕

經初步判斷，請求項 1~6 得以請求項 1 之技術內容作為預選之特別技術特徵，惟經檢索後認定請求項 1 不符專利要件具新穎性，故各請求

項所載之發明間無相同或對應之特別技術特徵，~~非屬同一廣義發明概念，故不具發明單一性。~~

~~請求項 2~6 直接或間接依附於請求項 1，因各請求項間已無相同或對應之特別技術特徵，此時得暫不進行進一步的檢索，於審查意見通知中應指出依現有引證文件內容認定請求項 1、2、3、6 不具新穎性、進步性及請求項 1~6 不具發明單一性之不准專利事由，並敘明請求項 4、5 因不具發明單一性而未檢索，待申請人申復後再續行審查。~~

#### 例 14.

〔申請專利範圍〕

1. 一種產物 X，其特徵為 A。
2. 一種產物 Y，其特徵為 B。
3. 一種產物 Z，其特徵為 A 及 B。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之具有特徵 A 之「產物 X」及請求項 2 之具有特徵 B 之「產物 Y」或 B 的該產物符合專利要件，而特徵 A 與特徵 B 不相關。

〔說明〕

請求項 1 中的之特徵 A 為特別技術特徵，請求項 3 亦具有該特徵 A，兩項具有相同之特別技術特徵，~~具有發明單一性。~~同理，請求項 2 與請求項 3 具有相同之特別技術特徵 B，~~具有發明單一性。~~惟請求項 1、2 不具相同或對應之特別技術特徵，~~不具發明單一性，故~~請求項 1、2、3 ~~項間~~仍無相同或對應的特別技術特徵，~~亦故~~不具發明單一性。~~但申請人如申請分割，仍得就不同發明內容取得專利權。~~

#### 例 15.

〔申請專利範圍〕

1. 一種用於紡織機的控制電路，具有特徵 A。
2. 一種用於紡織機的控制電路，具有特徵 B。
3. 一種○○設備，包括一台具有特徵 A 控制電路的紡織機。
4. 一種○○設備，包括一台具有特徵 B 控制電路的紡織機。

〔假設〕

就先前技術而言，具有特徵 A 之紡織機「控制電路」及具有特徵 B 之紡織機「控制電路」符合專利要件，而特徵 A 與特徵 B 完全不相關。

〔說明〕

特徵 A 為請求項 1、3 具有相同之的特別技術特徵 A，~~具有發明單一性，~~特徵 B 為請求項 2、4 具有相同之的特別技術特徵 B，~~具有發明單一性。~~由於特徵 A 與特徵 B 完全不相關，~~非屬相同或對應之技術特徵，~~

雖請求項 1、3 間具單一性，請求項 2、4 間亦具單一性，但因此請求項 1、2、3、4 間無相同或對應之特別技術特徵，故不具發明單一性。

#### 例 16.

〔申請專利範圍〕

1. 一種具有防臭物質 X 的塗料。
2. 一種應用請求項 1 所述之塗料塗佈製品的方法，包括下列步驟：  
(1) 以壓縮空氣將塗料噴成霧狀；(2) 將霧狀塗料通過一個電極裝置 A 使其帶電後再噴塗到製品上。
3. 一種噴塗設備，包括一個電極裝置 A。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之含有物質 X 的「塗料」符合專利要件，請求項 2、3 之「電極裝置 A」亦符合專利要件。

〔說明〕

含有物質 X 的塗料是請求項 1、2 具有之相同之特別技術特徵「含有物質 X 的塗料」，具有發明單一性，電極裝置 A 為請求項 2、3 之具有相同之特別技術特徵「電極裝置 A」，具有發明單一性，惟請求項 1、3 並無相同或對應之特別技術特徵，不具發明單一性，因此請求項 1、2、3 亦無相同或對應之特別技術特徵，亦故不具發明單一性。

#### 例 17.

〔申請專利範圍〕

1. 一種實施步驟 A 的設備，……。
2. 一種實施步驟 B 的設備，……。
3. 一種半導體元件製造方法，包括依序使用請求項 1 的設備實施步驟 A 及使用請求項 2 之設備實施步驟 B。

〔假設〕

就先前技術而言，最能代表發明之請求項 3 之製造方法符合專利要件，惟步驟 A、B 係不相同且不相對應。

〔說明〕

實施步驟 A 之設備係請求項 1、3 具有相同之特別技術特徵，即實施步驟 A 之設備，具有發明單一性。實施步驟 B 之設備係請求項 2、3 具有相同之特別技術特徵，即實施步驟 B 之設備，具有發明單一性。惟但請求項 1、2 無相同或對應之特別技術特徵，不具發明單一性，因此請求項 1、2、3 亦無相同或對應之特別技術特徵，亦故不具發明單一性。

#### 例 1.

〔申請專利範圍〕

~~1.一種產物 X。~~

~~2.一種製造產物 X 的方法 A，包含步驟 J，步驟 K，步驟 L。~~

~~3.一種製造產物 X 的方法 B，包含步驟 M，步驟 N，步驟 O。~~

~~4.一種製造產物 X 的方法 C，包含步驟 P，步驟 Q，步驟 R。~~

~~〔假設 1〕~~

~~就先前技術而言，產物 X 符合專利要件。~~

~~〔說明 1〕~~

~~請求項 1 之產物 X 為物之請求項 1 及方法請求項 2、3、4 相同的特別技術特徵，故具發明單一性。~~

~~〔假設 2〕~~

~~就先前技術而言，產物 X 不符合專利要件。~~

~~〔說明 2〕~~

~~請求項 1 之產物 X 不符合專利要件時，請求項 1、2、3、4 間即無相同或對應之特別技術特徵，故不具發明單一性。~~

~~如申請人於修正時刪除請求項 1 後，修正後請求項 1、2、3（修正前請求項 2、3、4）之間是否具發明單一性，仍須就該等請求項間是否具有相同或對應之特別技術特徵重新判斷。~~

### 例 2.

~~〔申請專利範圍〕~~

~~1.一種化合物 X。~~

~~2.一種製備化合物 X 的方法，包含下列步驟：.....。~~

~~3.化合物 X 作為清潔劑的應用。~~

~~〔假設 1〕~~

~~就先前技術而言，化合物 X 符合專利要件。~~

~~〔說明 1〕~~

~~請求項 1 之化合物 X 即請求項 1、2、3 間相同的特別技術特徵，故具發明單一性。~~

~~〔假設 2〕~~

~~就先前技術而言，化合物 X 不符專利要件。~~

~~〔說明 2〕~~

~~當請求項 1 之化合物 X 不符專利要件。應於審查意見通知指出化合物 X 不符專利要件及請求項 1~3 不具發明單一性。~~

~~如經修正申請專利範圍刪除請求項 1 後，請求項 2、3 間之相同技術特徵若仍為化合物 X 時，由於其非屬特別技術特徵，在無其他相同或對應之技術特徵的情況下，請求項 2、3 仍不具發明單一性。~~

### 例 3.

〔申請專利範圍〕

1. ~~一種高強度、耐腐蝕的不鏽鋼帶，其伸長率為 0.2% 時之降服強度超過 50 kg/mm<sup>2</sup>。~~
2. ~~一種製備如請求項 1 之不鏽鋼帶的方法，包含步驟。~~

〔假設〕

就先前技術而言，伸長率為 0.2% 時降服強度超過 50 kg/mm<sup>2</sup> 之不鏽鋼帶符合專利要件。

〔說明〕

請求項 1 之不鏽鋼帶係以「伸長率為 0.2% 時之降服強度超過 50 kg/mm<sup>2</sup>」為其特別技術特徵，請求項 2 之方法為說明書記載用以生產具該降服強度之不鏽鋼帶所採用者，請求項 2 雖未記載請求項 1 之該特別技術特徵，但說明書中已明確揭露此事項，該等步驟為對應於請求項 1 內容之特別技術特徵，故具發明單一性。

#### 例 4.

〔申請專利範圍〕

1. ~~一種具有防臭物質 X 的塗料。~~
2. ~~一種應用請求項 1 所述之塗料塗佈製品的方法，包括下列步驟：(1)以壓縮空氣將塗料噴成霧狀；(2)將霧狀塗料通過一個電極裝置 A 使其帶電後再噴塗到製品上。~~
3. ~~一種噴塗設備，包括一個電極裝置 A。~~

〔假設〕

就先前技術而言，含有物質 X 的塗料符合專利要件，電極裝置 A 亦符合專利要件。

〔說明〕

含有物質 X 的塗料是請求項 1、2 之相同特別技術特徵，電極裝置 A 為請求項 2、3 之相同特別技術特徵，惟請求項 1、3 並無相同或對應之特別技術特徵，請求項 1~3 不具發明單一性。

#### 例 5.

〔申請專利範圍〕

1. ~~一種處理紡織材料的方法，其特徵在於用塗料 A 在技術條件 B 下噴塗該紡織材料。~~
2. ~~一種依請求項 1 的方法噴塗而製得之一種紡織材料。~~
3. ~~一種噴塗機，其特徵在於有一噴嘴 C 能使塗料 A 均勻分布在紡織材料上。~~

〔假設〕

先前技術中已揭露使用塗料處理紡織品的方法，但未揭露請求項 1 所載

塗料 A 與技術條件 B，請求項 2 之紡織材料具有預想不到的特性，而請求項 3 之噴嘴 C 符合專利要件。

〔說明〕

請求項 1 的特別技術特徵為塗料 A 及技術條件 B，以塗料 A 及技術條件 B 處理紡織品之後，可製得請求項 2 所載之紡織材料，請求項 1、2 之相同特別技術特徵即該紡織材料，故具單一性。惟請求項 3 之噴塗機之噴嘴與前述特別技術特徵不相同亦不相對應，故請求項 1~3 不具發明單一性。

#### 例 6.

〔申請專利範圍〕

1. 一種實施步驟 A 的設備，……。
2. 一種實施步驟 B 的設備，……。
3. 一種半導體元件製造方法，包括依序使用請求項 1 的設備實施步驟 A 及使用請求項 2 之設備實施步驟 B。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 3 之製造方法符合專利要件，惟步驟 A、B 係不相同且不相對應。

〔說明〕

實施步驟 A 之設備係請求項 1、3 相同之技術特徵，實施步驟 B 之設備係請求項 2、3 相同之技術特徵，但請求項 1、2 無相同或對應之特別技術特徵，故請求項 1~3 不具發明單一性。

#### 例 7.

〔申請專利範圍〕

1. 一種光纖電纜，包含一絞繞結構……。
2. 一種光纖電纜之製法，包含一搓撚步驟……。

〔假設〕

就先前技術而言，請求項 1 之光纖電纜包含之絞繞結構符合專利要件。請求項 2 之製法包含之搓撚步驟係於製造光纖電纜時形成該絞繞結構。

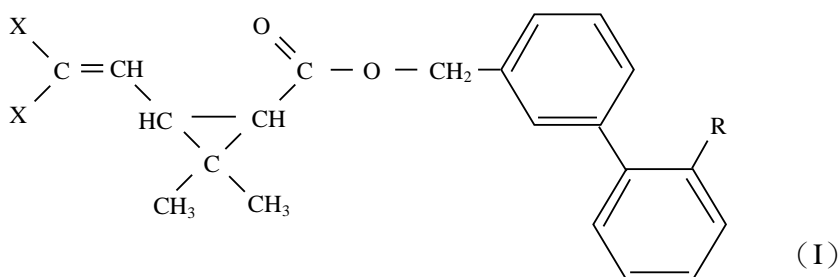
〔說明〕

請求項 2 之搓撚步驟技術特徵係與請求項 1 之絞繞結構技術特徵對應，故具發明單一性。

#### 例 8.

〔申請專利範圍〕

1. 一種環丙烷羧酸酯衍生物，係以一般式(I)表示者：



式內，X為氯或溴，R表示鹵素、低級烷基、三氟甲基或低級烷氧基。  
~~2.一種殺蟲劑組成物，其係含有至少一種請求項1所述的化合物為有效成分。~~

~~3.一種殺蟲方法，其係將有效量之至少一種請求項1所述化合物施用於欲驅除昆蟲之場所。~~

〔假設〕

就先前技術而言，請求項1「環丙烷羧酸酯衍生物」符合專利要件。

〔說明〕

請求項2之「殺蟲劑組成物」包含請求項1之「環丙烷羧酸酯衍生物」，請求項3之「殺蟲方法」係使用請求項1「環丙烷羧酸酯衍生物」之方法，請求項1之化合物為請求項1、2、3之相同的特別技術特徵，故具發明單一性。

### 例9.

〔申請專利範圍〕

- ~~1.一種電源之整流器電路，……。~~
- ~~2.一種多孔矽藍光發光二極體之製造方法……。~~

〔說明〕

請求項2「藍光發光二極體之製造方法」與請求項1「整流器電路」無關，請求項1、2無相同或對應之特別技術特徵，故不具發明單一性。

### 例10.

〔申請專利範圍〕

- ~~1.一種在液相中的芳香族化合物之硝化反應之方法，……。~~
- ~~2.一種除去液相中芳香族化合物硝化反應之反應熱的裝置，……。~~

〔說明〕

請求項2「除去液相中芳香族化合物硝化反應之反應熱的裝置」並非實施請求項1「硝化反應方法」所使用者，請求項1、2無相同或對應之特別技術特徵，不具發明單一性。

### 例11.

~~〔申請專利範圍〕~~

~~1.一種具有細胞碎裂電解裝置之微流裝置，包含有一陽極室、一陰極室以及一阻隔體……。~~

~~2.一種使用申請專利範圍請求項1之微流裝置碎裂細胞之方法，該方法包含有：自該陽極室之該入口導入該陽極室溶液…；自該陰極室之該入口導入該陰極室溶液……。~~

~~〔說明〕~~

~~請求項2的碎裂細胞方法之步驟中，係使用請求項1的碎裂裝置，相同之技術特徵為請求項1之裝置，故請求項1、2具發明單一性。~~